



อิทธิพลของอุณหภูมิอบอ่อนต่อโครงสร้างและสัณฐานวิทยาของ ฟิล์มบางโคโรเมียมอะลูมิเนียมในไตรเดค

เจนจิรา สนันรงค์^{1,2}, อดิศร บูรณวงศ์^{1,2} และนิรันดร์ วิทิตอนันต์^{1,2*}

¹ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี

²ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิสิกส์ (ThEP), กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI), กรุงเทพฯ

*nirun@buu.ac.th

บทคัดย่อ

ฟิล์มบางโคโรเมียมอะลูมิเนียมในไตรเดค (CrAlN) ถูกเคลือบบนแผ่นซิลิคอนด้วยเทคนิคเอดเดคติฟดีซีอันบาลานซ์เมกนีตรอน สปัตเตอริ่งจากเป้าสารเคลือบแบบอัลลอยแล้วนำไปอบอ่อนในอากาศที่อุณหภูมิต่าง ๆ ในช่วง 500 - 900 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิอบอ่อนต่อโครงสร้างและสัณฐานวิทยาของฟิล์มที่เคลือบได้ โดยโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมีและ สัณฐานวิทยาของฟิล์มศึกษาด้วยเทคนิค XRD, EDS และ FE-SEM ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มที่ได้เป็นสารละลายของแข็ง ของ (Cr,Al)N ระนาบ (111), (200) และ (220) ทั้งนี้ฟิล์มที่เคลือบได้มีโคโรเมียม (Cr) อะลูมิเนียม (Al) และไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบหลักในอัตราส่วนต่าง ๆ และมีออกซิเจน (O) ปนอยู่บางส่วน โดยฟิล์มนี้มีค่าคงที่แลตทิชในช่วง 4.055 – 4.139 Å ส่วนขนาดผลึกเฉลี่ยมีค่าในช่วง 14.8 – 20.3 nm สำหรับผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและภาคตัดขวางของฟิล์มบาง จากเทคนิค FE-SEM แสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางโคโรเมียมอะลูมิเนียมในไตรเดคที่เคลือบได้มีโครงสร้างเป็นแบบคอลัมนาร์ ทั้งนี้เมื่อนำ ฟิล์มบางโคโรเมียมอะลูมิเนียมในไตรเดคไปอบอ่อนที่อุณหภูมิในช่วง 500 - 900 °C พบว่าโครงสร้างจุลภาคของฟิล์มนี้คงโครงสร้าง แบบคอลัมนาร์ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความร้อนจากกระบวนการอบอ่อน นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้เมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มสูงขึ้น เป็น 900 °C พบว่าปริมาณออกซิเจนในเนื้อฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่พบโครงสร้างผลึก (จากเทคนิค XRD) หรือชั้นของออกไซด์ (จากเทคนิค FE-SEM) ซึ่งเป็นการยืนยันและแสดงให้เห็นว่าการเจืออะลูมิเนียมในฟิล์มสามารถช่วยต้านทาน การเกิดออกซิเดชันของฟิล์มได้สูงถึง 900 °C

คำสำคัญ: ฟิล์มบาง โคโรเมียมอะลูมิเนียมในไตรเดค สปัตเตอริ่ง อุณหภูมิอบอ่อน ชั้นเคลือบแข็ง



Influence of Annealing Temperature on the Structure and Morphology of Chromium Aluminum Nitride Thin Films

Jenjira Sonnarong^{1,2}, Adisorn Buranawong^{1,2} and Nirun Witit-anun^{1,2*}

¹Department of Physics, Faculty of Science, Burapha University, Chon Buri

²Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP), Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), Bangkok

*nirun@buu.ac.th

Abstract

Chromium aluminium nitride (CrAlN) thin films were deposited on Si by using reactive DC unbalanced magnetron sputtering technique from alloy target and then annealed in air at different temperatures, in the range of 500 - 900 °C, for 1 hr. The effect of annealing temperature on the structure and morphology of the as-deposited films were investigated. The structure, chemical composition, and morphology of the thin films were characterized using XRD, EDS, and FE-SEM, respectively. The results show that the as-deposited films were solid solutions of (Cr,Al)N with (111), (200), and (220) planes. The as-deposited film has chromium (Cr), aluminium (Al), and nitrogen (N) as the main composition in different ratios, with some oxygen (O). The lattice constant was in the range of 4.055 – 4.139 Å. The average crystal size was in the range of 14.8 – 20.3 nm. The microstructure and cross-section analysis result from the FE-SEM technique was revealed that the as-deposited CrAlN thin film shows the compact columnar structure. The microstructure of the CrAlN thin film was unchanged by heat from the annealing process at temperatures in the range of 500 - 900 °C. However, in this work, when the annealing temperature was increased up to 900 °C, a slight increase in oxygen content in the films, and the crystal structure (from XRD technique) or layer of the oxides (from FE-SEM technique) were not observed showed that alloyed aluminium in the film can improve the oxidation resistance up to 900 °C.

Keywords: Thin film, Chromium Aluminium Nitride, sputtering, annealing temperature, hard coating



1. บทนำ

หอยท่อควรจะที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มวิจัยทั่วโลกได้ให้ความสนใจวิจัยและพัฒนา เทคนิคและกระบวนการปรับปรุงผิววัสดุเพื่อให้มีสมบัติเฉพาะด้านตามที่ต้องการ โดยการเคลือบด้วยสารเคลือบที่เหมาะสมให้เป็นชั้นเคลือบที่มีลักษณะเป็นชั้นของฟิล์มบาง (thin films) ด้วยวิธีการเคลือบในสูญญากาศ (vacuum coating) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการเคลือบด้วยไออกายภาพ (Physical Vapor Deposition; PVD) หรือที่เรียกว่าเทคนิค PVD ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาระบุกตื้อใช้งานในหลายด้าน เช่น การเคลือบแสง (optical coating) เพื่อให้ชั้นงานมีการส่งผ่านแสงที่ดีหรือมีการส่งผ่านแสงบางช่วงที่ต้องการหรือเพื่อป้องกันการสะท้อนแสง หรือ การเคลือบความสวยงาม (decorative coating) เพื่อให้ผิวของวัสดุงานหั่นหรือมีลักษณะคล้ายผิวโลหะ รวมถึงยังให้สีที่สวยงาม และการเคลือบแข็ง (hard coating) เพื่อทำให้ผิวของชั้นงานที่ถูกเคลือบมีความทนทานต่อการขัดสี ระหว่างการใช้งานซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งาน เป็นต้น

การเคลือบแข็งจัดเป็นการประยุกต์ใช้ฟิล์มบางที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับปรุงผิวของอุปกรณ์ และเครื่องมือช่างในกลุ่มกึ่ง กัด ตัด เจาะ ทั้งนี้การเคลือบแข็งซึ่งมีตั้งแต่ประสิทธิภาพเพื่อทำให้ผิวของชั้นงานมีความแข็งและทนทานมากขึ้นด้วยการเคลือบด้วยชั้นเคลือบแข็งหรือฟิล์มบางแข็ง (hard thin film) ของสารประกอบในไตรดของธาตุแทรนซิชัน โดยยุคแรกนิยมใช้ฟิล์มบางไทดเนียมในไตรด (TiN) โครเมียมในไตรด (CrN) และ เชอร์โคเนียมในไตรด (ZrN) ซึ่งเป็นชั้นเคลือบของสารประกอบของธาตุสองชนิด (binary coating) เนื่องจากมีสมบัติที่ดีหลายด้าน เช่น มีความแข็งสูง ทนการขัดขีดขัดสีได้ดี มีจุดหลอมเหลวสูง มีเสถียรภาพทางเคมีและความร้อนดี [1] อย่างไรก็ต้องมีความตั้งกล้าวที่ยังมีความยากจ่ายในการเตรียมที่ต่างกัน ทั้งนี้ฟิล์มบางชนิดหนึ่งที่น่าสนใจคือโครเมียมในไตรดเนื่องจากมีความแข็งใกล้เคียงไทดเนียมในไตรดแต่เตรียมได้ง่ายกว่า อีกทั้งยังมีสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น ต้านทานการขัดสีและการกัดกร่อนได้ดีที่อุณหภูมิสูง [2] แต่ฟิล์มบางโครเมียมในไตรดก็ยังมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับการสื่อสารภาพเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 600°C เนื่องจากชั้นฟิล์มจะทำปฏิกิริยา กับออกซิเจน ในบรรยากาศแล้วเกิดการออกซิเดชันกลایเป็นสารประกอบออกไซด์แทรกตัวอยู่ในชั้นฟิล์มบางโครเมียมในไตรดซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงกลของฟิล์มหรืออาจทำให้ชั้นฟิล์มหลุดลอกออกจากชั้นงานที่เคลือบทาให้หายการใช้งานลดลงในที่สุด [3]

แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการสื่อสารภาพของฟิล์มบางแข็งดังกล่าวข้างต้นสามารถทำได้โดยการเจือหรือเติมอะตอนของธาตุบางชนิดเข้าไปในโครงสร้างหลักของชั้นเคลือบของสารประกอบของธาตุสองชนิด ซึ่งทำให้เกิดเป็นชั้นเคลือบของสารประกอบของธาตุสามชนิด (ternary coating) ที่มีความแข็งและต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ดีมากยิ่งขึ้น [4] ทั้งนี้ จากรายงานวิจัยของ Xingrun และคณะ (2018) พบว่าการเจืออะลูมิเนียมเข้าไปในโครงสร้างหลักของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด จะทำให้เกิดการฟอร์มตัวเป็นชั้นเคลือบของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด (CrAlN) ซึ่งเป็นฟิล์มที่มีความแข็งมากกว่าฟิล์มบางโครเมียมในไตรด และยังมีสมบัติในการต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงได้ดีกว่าอีกด้วย [5] นอกจากนี้ จากรายงานวิจัยของ Li และคณะ (2012) พบว่าฟิล์มโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรดสามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ถึง 800°C และยังมีความแข็งสูงมากถึง 48 GPa เนื่องจากเกิดการฟอร์มตัวของออกไซด์เชิงชั้นของ Cr_2O_3 และ Al_2O_3 ในโครงสร้างหลักของฟิล์ม [3,6] ซึ่งเป็นการสนับสนุนและยืนยันแนวคิดของการเจือธาตุอะลูมิเนียมในโครงสร้างของโครเมียมในไตรดสามารถช่วยเพิ่มความแข็งและสมบัติต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงได้

สำหรับการเตรียมฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรดโดยการเคลือบในสูญญากาศด้วยเทคนิค PVD จากวิธีสปัตเตอริ่ง สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งแบ่งได้ตามชนิดของเป้าสารเคลือบที่ใช้ ได้แก่ การเคลือบด้วยเป้าสารเคลือบแบบเป้าร่วม (Co-target) หรือเป้าแบบอลลอย (alloy target) หรือเป้าแบบเซกเมนต์ (segment target) หรือเป้าแบบโมเสก (mosaic target) ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป [7] ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด ส่วนใหญ่เน้นศึกษาผลของเงื่อนไขที่ใช้ในการเคลือบต่อลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางที่เคลือบได้ด้วยวิธีสปัตเตอริ่งจากเป้าแบบร่วม



อย่างไรก็ได้การเตรียมพิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์นี้จากเป้าสารเคลือบแบบอัลลอยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน นอกจากนี้การศึกษาผลของอุณหภูมิอบอุ่นต่อโครงสร้าง สัมฐานวิทยาและการเกิดออกซิเดชัน เนื่องจากความร้อนของพิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์นี้ก็ยังมีการศึกษาไม่มากและอยู่ในวงจำกัดเท่านั้น

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยซึ่งคณะผู้วิจัยกำลังดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพิล์มบางแข็งของสารประกอบของธาตุสามชนิดที่มีโครเมียมเป็นหลัก (Cr-based ternary hard coating) โดยบทความนี้เป็นการรายงานผลการศึกษาในส่วนของการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิอบอุ่นที่มีผลต่อโครงสร้างและสัมฐานวิทยาของพิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคติฟดีซีอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริ่งจากเป้าสารเคลือบแบบอัลลอย โดยนำพิล์มที่เตรียมได้ไปอบอุ่นในอุ่นภูมิในช่วง 500 – 900 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมงแล้วนำพิล์มทั้งหมดมาศึกษาลักษณะเฉพาะได้แก่ โครงสร้างผลึกโครส์รั่งสีอุลกาค ลักษณะพื้นผิว องค์ประกอบทางเคมีของพิล์ม ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการเลี้ยวเบนริงส์เอกซ์ (XRD) กัลลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) และเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (EDS) ตามลำดับ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัยและประยุกต์ใช้ต่อไป

2. วิธีดำเนินการวิจัย

พิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ (CrAlN) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมบนแผ่นชิลิคอนด้วยวิธีรีแอคติฟดีซีอันบาลานซ์ แมกนีตรอนสปัตเตอริ่งจากเครื่องเคลือบในสัญญาการ (ภาพที่ 1) ซึ่งมีห้องเคลือบทำจากสแตนเลสเป็นทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 31.0 cm สูง 31.0 cm มีแค็ปodeชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำยาติดตั้งที่แผ่นปิดบนของห้องเคลือบ แค็ปodeเป็นแบบอันบาลานซ์แมกนีตรอนแค็ปode ซึ่งทำได้โดยติดตั้งแต่แม่เหล็กความเข้ม 1800 G ที่กึ่งกลางและ 1300 G ที่ด้านข้างของแค็ปode สำหรับระบบเครื่องสูบสัญญาการงานวิจัยนี้ใช้เครื่องสูบแบบแพร์โอชันด้วยความร้อนด้วยน้ำซึ่งมีเครื่องสูบกลไกเป็นเครื่องสูบห้าม ในส่วนการวัดความดันในห้องเคลือบใช้ระบบวัดความดันของ PFEIFFER ซึ่งใช้ส่วนแสดงผลรุ่น TPG262 และใช้มาตรวัดความดันชนิด Compact Full Range Gauge รุ่น PKR251 แก๊สที่ใช้เคลือบมี 2 ชนิด คือแก๊สอาร์กอน (99.999%) เป็นแก๊สปัตเตอร์ (sputter gas) และแก๊สไนโตรเจน (99.995%) เป็นแก๊สไวปฏิกิริยา (reactive gas) โดยแก๊สทั้งสองชนิดจะเข้าห้องเคลือบผ่านการควบคุมด้วยเครื่องควบคุมอัตตราไหลมวลแก๊สของ MKS รุ่น type247D

ขั้นตอนการเตรียมพิล์มบางเริ่มจากนำวัสดุรองรับ (แผ่นชิลิคอน) เข้าห้องเคลือบโดยวางห่างจากหน้าเป้าสารเคลือบเท่ากับ 10.0 cm จากนั้นสร้างภาวะสูญญากาศโดยลดความดันภายในห้องเคลือบจนได้ความดันพื้นเท่ากับ 5.0×10^{-5} mbar และปล่อยแก๊สที่ใช้ (แก๊สอาร์กอนและแก๊สไนโตรเจน) เข้าห้องเคลือบ โดยกำหนดให้อัตราไฟแก๊สอาร์กอนและแก๊สไนโตรเจน มีค่าคงที่ตลอดการเคลือบท่ากับ 20.0 sccm และ 6.0 sccm ตามลำดับ ทั้งนี้ระหว่างการเตรียมพิล์มจะควบคุมความดันให้คงที่เท่ากับ 5.0×10^{-3} mbar ตลอดการเคลือบด้วยการปรับเวลาสูญญากาศสูง โดยพิล์มบางแต่ละชุดใช้เวลาเคลือบนาน 30 นาที สำหรับเงื่อนไขการเคลือบท่ากับ 20.0 sccm และ 6.0 sccm ตามลำดับ ทั้งนี้ระหว่างการเตรียมพิล์มจะควบคุมความดันให้คงที่เท่ากับ 5.0×10^{-3} mbar ตลอดการเคลือบด้วยการปรับเวลาสูญญากาศสูง โดยพิล์มบางแต่ละชุดใช้เวลาเคลือบนาน 30 นาที ในอุณหภูมิในอัตราคงที่จนถึงอุณหภูมิที่กำหนด จากนั้นอบให้ความร้อนต่อไปเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นลดอุณหภูมิของขั้นงาน โดยปล่อยให้อุณหภูมิลดลงในบรรยายการปกติจนถึงอุณหภูมิท้องก่อนนำพิล์มบางออกจากเตาอบแล้วนำไปวิเคราะห์ต่อไป

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบาง

พารามิเตอร์การเคลือบ	รายละเอียด
เป้าสารเคลือบ	เป้าอัลลอยของ Cr-Al
อุณหภูมิขณะเคลือบ	อุณหภูมิห้อง
ระยะห่างของวัสดุรองรับ	10.0 cm
ความดันพื้น	5.0×10^{-5} mbar
ความดันรวมขณะเคลือบ	5.0×10^{-3} mbar
อัตราไฟลแก๊สอาร์กgon	20.0 sccm
อัตราไฟลของแก๊สในไตรเจน	6.0 sccm
กำลังสปีตเตอร์วิง	226 W
เวลาเคลือบ	30 min



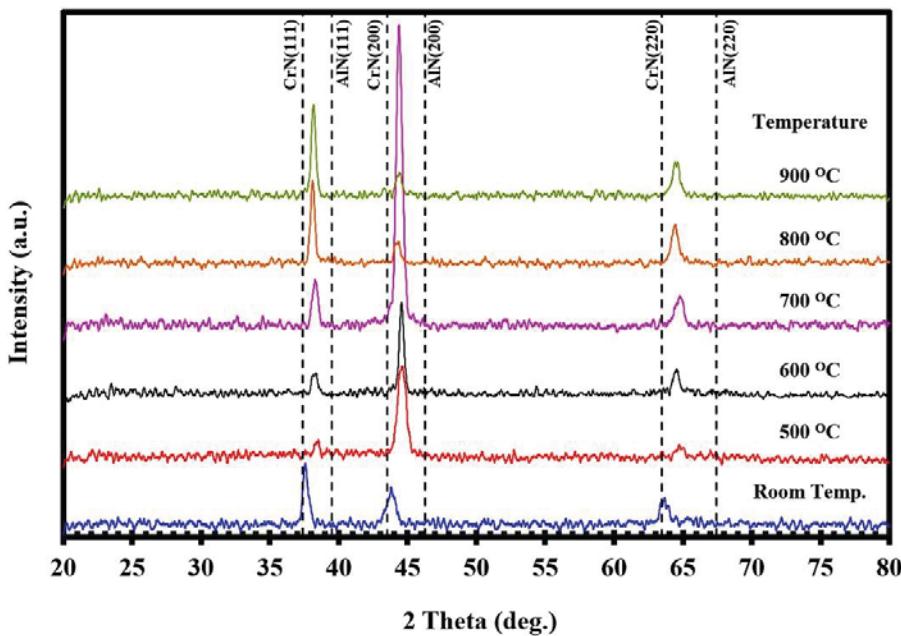
ภาพที่ 1 ลักษณะของเครื่องเคลือบและพลาสม่า

ฟิล์มบางทั้งหมดในงานวิจัยนี้ถูกนำไปศึกษาลักษณะเฉพาะด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้ (1) โครงสร้างผลึก ศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) ด้วยเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ Bruker รุ่น D8 ADVANCE โดยตรวจวัดแบบ 2θ-scan ด้วยมุมตกกระทบทนเฉียง (grazing incident angle) เท่ากับ 2° และตรวจวัดมุม 2θ ระหว่างมุม 20° ถึง 80° (2) ขนาดผลึก (crystal size) คำนวณด้วยสมการของ Scherrer จากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ตรวจวัดได้ (3) โครงสร้างจุลภาค ลักษณะพื้นผิว ภาคตัดขวางและความหนา ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) ของ Hitachi รุ่น s4700 และ (4) องค์ประกอบทางเคมี ศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (EDS) ของ EDAX ซึ่งติดตั้งต่อพ่วงอยู่กับกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ของ LEO รุ่น 1450VP



3. ผลและอภิปรายผลการวิจัย

โครงสร้างผลึกของฟิล์มบางที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ก่อนและหลังการอบอุ่นที่อุณหภูมิในช่วง $500 - 900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ได้รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ดังภาพที่ 2 แต่เนื่องจากสารประกอบโครงเมียมอะลูминีียมไม่โครงสร้างเป็นแบบสารละลายของแข็ง (solid-solution) ซึ่งไม่มีโครงสร้างผลึกที่แน่นอนจึงไม่มีข้อมูลมาตรฐานสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบ ผู้วิจัยจึงได้เพิ่มข้อมูลซึ่งระบุมุนของรูปแบบ ของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มาตรฐานของโครงเมียมไนโตรด (JCPDS No.65-2899) และอะลูминีียมไนโตรด (JCPDS No.88-2250) สำหรับเปรียบเทียบกับผลของฟิล์มที่ได้ทั้งนี้ผลจากการศึกษาพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้ซึ่งยังไม่อบอุ่นมีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน $37.59^{\circ}, 43.82^{\circ}$ และ 63.66° ซึ่งเป็นมุนที่อยู่ระหว่างมุนของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครงเมียมไนโตรด (CrN) และอะลูминีียมไนโตรด (AlN) ที่รั้นนาบ (111), (200) และ (220) โดยไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครงเมียมไนโตรดและอะลูминีียมไนโตรด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้เป็นฟิล์มบางของสารละลายของแข็งของ (Cr, Al)N ที่มีโครงสร้างผลึกแบบ fcc ซึ่งเกิดจากการที่อ่อนตัวของธาตุโครงเมียม (รัศมีอ่อนตัวที่ 0.139 nm) ในโครงสร้างของโครงเมียมไนโตรดถูกแทนที่ด้วยอ่อนตัวของธาตุอะลูминีียมซึ่งมีขนาดเล็กกว่า (รัศมีอ่อนตัวที่ 0.121 nm) [3] โดยฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าคงที่แลตทิชเท่ากับ 4.139 \AA ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างค่าคงที่แลตทิชของอะลูминีียมไนโตรด (3.938 \AA) และ โครงเมียมไนโตรด (4.148 \AA) กรณีนี้จึงทำให้มุนของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้มีการเลื่อนไปทางขวาเมื่อของมุนของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครงเมียมไนโตรด [8]



ภาพที่ 2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครงเมียมอะลูминีียมไนโตรดที่อุณหภูมิอบอุ่นต่าง ๆ

ทั้งนี้เมื่อนำฟิล์มบางที่เคลือบได้ไปอบอุ่นในอากาศปกติที่อุณหภูมิในช่วง $500 - 900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำฟิล์มทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ได้รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ จำนวน 3 มุน ดังแสดงในภาพที่ 2 คือที่มุนประมาณ $38.15^{\circ} - 38.40^{\circ}, 44.25^{\circ} - 44.56^{\circ}$ และ $64.43^{\circ} - 64.84^{\circ}$ สอดคล้องกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครงเมียมอะลูминีียมไนโตรดที่รั้นนาบ (111), (200) และ (220) [6] ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับฟิล์มบางที่เคลือบได้ที่อุณหภูมิห้องและยังไม่อบอุ่น



ทั้งนี้หากพิจารณาความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่ผ่านการอบอ่อนที่อุณหภูมิในช่วง $500 - 900^{\circ}\text{C}$ พบว่า ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่ใช้ในการอบอ่อน โดยพบว่าที่อุณหภูมิ อบอ่อนเท่ากับ 500°C ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ระนาบ (200) มีค่าสูงสุด ขณะที่ระนาบ (111) และ (220) มี ค่าค่อนข้างต่ำใกล้เคียงกัน และเมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 600°C และ 700°C ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ทั้งสามระนาบมีค่าเพิ่มสูงสุด โดยที่ระนาบ (200) มีค่าความเข้มสูงสุด แต่เมื่ออุณหภูมิอบอ่อนเพิ่มขึ้นเป็น 800°C และ 900°C กลับพบว่าความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่ระนาบ (200) มีค่าลดลง ขณะที่ระนาบ (111) และ (220) มีค่าเพิ่มขึ้น

ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD แสดงให้เห็นว่าความร้อนจากการอบอ่อนทำให้ (1) ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาในภาพรวมพบว่าความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีค่าเพิ่มสูงขึ้นทั้งหมด ตามอุณหภูมิอบอ่อนทั้ง 3 ระนาบ ผลในส่วนแรกให้เห็นว่าฟิล์มมีความเป็นผลึก (crystallinity) มากขึ้น เนื่องจากความร้อนที่ใช้ในการอบอ่อนมีค่าหรือมีปริมาณที่สูงมากพอเทียบเท่าการเพิ่มพลังงานให้แก่ก่อตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของฟิล์มที่เคลือบได้บนวัสดุรองรับโดยตรง กรณีนี้ทำให้ห้องตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของฟิล์มมีการรวมตัวหรือเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของผลึก (recrystallize) ซึ่งส่งผลให้ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์มีค่าเพิ่มสูงขึ้น และ (2) ผลจากการจัดเรียงตัวใหม่ของผลึก เนื่องจากความร้อนจากการอบอ่อนที่เพิ่มสูงขึ้น ผลที่เกิดขึ้นทำให้ผลึกของฟิล์มมีการเปลี่ยนโครงสร้าง จากระนาบ (200) (ที่อุณหภูมิอบอ่อนในช่วง $500 - 700^{\circ}\text{C}$) ไปเป็นระนาบ (111) (ที่อุณหภูมิอบอ่อนในช่วง $800 - 900^{\circ}\text{C}$) ขณะที่ ระนาบ (220) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้หากพิจารณาจากรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางคราเมียมอะลูминเนียมในไตรด์ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ เมื่ออุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งพบเพียงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เคลือบได้จำนวน 3 มุน หรือ 3 ระนาบคือ (111), (200) และ (220) ซึ่งอยู่ระหว่างรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครเมียมในไตรด์และอะลูมิเนียม ในไตรด์เท่านั้น โดยไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของโครเมียม (Cr) หรืออะลูมิเนียม (Al) แสดงให้เห็นว่าอัตโนมัติของธาตุ โครเมียมและอะลูมิเนียมที่ใช้ในกระบวนการเคลือบซึ่งถูกสัปตเตอร์ออกมายากมากเป้าอัลลอยของโครเมียม-อะลูมิเนียม (Cr-Al alloy target) มีการทำปฏิกิริยาหรือมีการฟอร์มตัวเป็นฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบสารละลายของแข็ง ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ผลจากเทคนิค XRD ดังแสดงในภาพที่ 2 ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารประกอบออกไซด์ที่ซึ่งเคลือบได้ในไตรด์ที่ต้องการ ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้หลังการอบอ่อนที่อุณหภูมิสูง ยังไม่เกิดสารประกอบออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึก อย่างไรก็ได้ออกซิเจนในบรรยากาศอาจทำปฏิกิริยากับอัตโนมัติของโครเมียมหรือ อะลูมิเนียมในเนื้อฟิล์มบางส่วนแล้วกลายเป็นสารประกอบออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบอสัมธาน (amorphous) ที่มีปริมาณน้อย จึงไม่สามารถตรวจสอบด้วยเทคนิค XRD ผลการวิจัยส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้สามารถทนหรือต้านทานการเกิดออกซิเดชันเนื่องจากความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ถึง 900°C สอดคล้องกับงานวิจัยของ Li และคณะ (2012) ซึ่งพบว่าฟิล์มโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์สามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ถึง 800°C เนื่องจากเกิดการฟอร์มตัวของออกไซด์เชิงช้อนของ Cr_2O_3 และ Al_2O_3 ที่มีโครงสร้างแบบอสัมธานในโครงสร้างหลักของฟิล์ม [3]

สำหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ทั้งหมดในงานวิจัยนี้ซึ่งคำนวณจากการของ Scherrer [9] แสดงได้ดังตารางที่ 2 พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้ก่อนอบอ่อนมีโครงสร้างในระดับนาโนเมตรเนื่องจากขนาดผลึกของฟิล์มทุกรายนาบมี ขนาดน้อยกว่า 25 nm โดยมีขนาดผลึกเฉลี่ยทุกรายนาบท่ากับ 15.7 nm นอกจากนี้ยังพบว่าขนาดผลึกของฟิล์มที่ผ่านการอบอ่อน มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่ใช้อบอ่อน ทั้งนี้หากพิจารณาภาพรวมพบว่าขนาดผลึกทุกรายนาบของฟิล์มโครเมียมอะลูมิเนียม ในไตรด์หลังอบอ่อนมีค่าในช่วง $13.4 - 22.1 \text{ nm}$ ซึ่งยังจัดเป็นโครงสร้างระดับนาโนเมตร (ขนาดผลึกน้อยกว่า 25 nm) ทั้งนี้หากพิจารณาขนาดผลึกเฉลี่ยของฟิล์มที่ได้พบว่าขนาดผลึกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอบอ่อนเนื่องจากพลังงานความร้อนที่ใช้ใน



กระบวนการอบอ่อนทำให้อะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของฟิล์มเกิดการจัดเรียงผลึกใหม่หรือมีโอกาสในการรวมตัวกันมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ผลึกมีขนาดเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิอบอ่อน ยกเว้นที่อุณหภูมิ 700°C ซึ่งพบว่าขนาดผลึกเฉลี่ยมีค่าลดลง ซึ่งผลที่ได้นี้ สอดคล้องกับผล XRD ที่พบว่าฟิล์มบางซึ่งอบอ่อนที่อุณหภูมิ 700°C ฟิล์มมีรูนาบ (200) สูงสุด

ตารางที่ 2 ความหนา ขนาดผลึกและค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางโครเมียมอะลูминีียมในไตรด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ

อุณหภูมิอบอ่อน ($^{\circ}\text{C}$)	ความหนา (nm)	ขนาดผลึก (nm)				ค่าคงที่แลตทิช (\AA)		
		(111)	(200)	(220)	เฉลี่ย	(111)	(200)	(220)
อุณหภูมิห้อง	683.5	19.9	12.6	14.6	15.7	4.139	4.127	4.129
500	649.5	21.0	16.5	21.4	19.6	4.055	4.062	4.062
600	671.0	19.1	21.5	20.4	20.3	4.072	4.062	4.081
700	669.5	15.6	15.3	13.4	14.8	4.067	4.076	4.068
800	680.5	22.1	19.1	17.4	19.5	4.081	4.089	4.085
900	693.5	18.3	17.9	14.7	16.9	4.079	4.079	4.080

ส่วนค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางโครเมียมอะลูминีียมในไตรด์ทั้งหมดในงานวิจัยนี้ทั้งที่เคลือบได้โดยไม่ผ่านกระบวนการอบอ่อน และที่ผ่านกระบวนการอบอ่อน สรุปดังแสดงในตารางที่ 2 พบร้าฟิล์มบางโครเมียมอะลูминีียมในไตรด์ที่เคลือบได้โดยไม่ผ่านกระบวนการอบอ่อนมี ค่าคงที่แลตทิชในช่วง $4.127 - 4.139 \text{ \AA}$ และเมื่อนำฟิล์มไปอบอ่อนพบว่าค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ที่ใช้ในการอบอ่อน โดยค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มหลังการอบอ่อนมีค่าคงที่แลตทิชอยู่ในช่วง $4.055 - 4.089 \text{ \AA}$ และหากพิจารณา แยกตามรูนาบของฟิล์ม พบร้าที่ รูนาบ (111) ค่าคงที่แลตทิชมีค่าในช่วง $4.055 - 4.081 \text{ \AA}$ ส่วนที่รูนาบ (200) และ (220) มีค่าในช่วง $4.062 - 4.089 \text{ \AA}$ และ $4.062 - 4.085 \text{ \AA}$ ตามลำดับ ซึ่งพบว่ายังคงมีค่าอยู่ระหว่างค่าของที่แลตทิชของอะลูминีียม ในไตรด์ (3.938 \AA ; JCPDS No.88-2250) และ โครเมียมในไตรด์ (4.148 \AA ; JCPDS No.65-2899) ผลการศึกษาในส่วนนี้แสดง ให้เห็นว่าการอบอ่อนฟิล์มบางโครเมียมอะลูминีียมในไตรด์ที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ไม่มีผลหรือไม่ทำให้โครงสร้างของฟิล์มบาง โครเมียมอะลูминีียมในไตรด์ที่เคลือบได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยังไม่ทำให้เกิดโครงสร้างของสารประกอบออกไซด์ ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าฟิล์มที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้มีความทนหรือสามารถต้านทานการเกิดออกซิเดชันเนื่องจากความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 900°C

ตารางที่ 3 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางโครเมียมอะลูминีียมในไตรด์ที่เคลือบได้ทั้งก่อนและหลังการอบอ่อน ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS พบร้าฟิล์มบางที่เคลือบได้ก่อนนำไปอบอ่อนมี ธาตุโครเมียม (Cr) อะลูминีียม (Al) และ ไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณต่าง ๆ กล่าวคือ มีปริมาณโครเมียมเท่ากับ 10.61 at\% อะลูминีียมเท่ากับ 24.01 at\% และไนโตรเจนเท่ากับ 47.11 at\% โดยมีออกซิเจน (O) เจือปนอยู่บางส่วนประมาณ 18.27 at\% ส่วนองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางโครเมียมอะลูминีียมในไตรด์ภายหลังการอบอ่อนในอุณหภูมิ $500 - 900^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง พบร้าองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ใช้ใน การอบอ่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยพบว่าปริมาณโครเมียมลดลงจาก 10.78 at\% เป็น 10.15 at\% ส่วนอะลูминีียมลดลง จาก 23.07 at\% เป็น 21.87 at\% และไนโตรเจนลดลงจาก 48.10 at\% เป็น 46.36 at\% ขณะที่ออกซิเจนปริมาณเพิ่มขึ้น เล็กน้อยจาก 18.05 at\% เป็น 21.62 at\%



ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ

อุณหภูมิอบอ่อน (°C)	องค์ประกอบทางเคมี (at%)			
	Cr	Al	N	O
อุณหภูมิห้อง	10.61	24.01	47.11	18.27
500	10.78	23.07	48.10	18.05
600	11.26	24.37	43.46	20.91
700	10.06	20.20	49.71	20.03
800	10.67	22.85	46.80	19.67
900	10.15	21.87	46.36	21.62

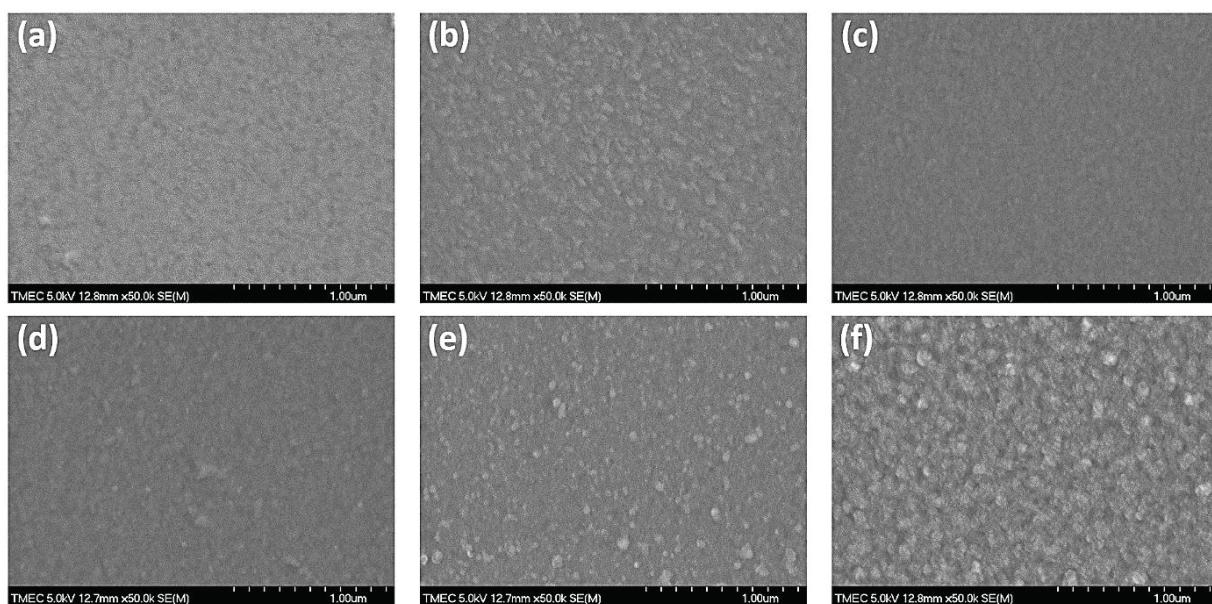
ทั้งนี้หากพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่เคลือบได้ทั้งก่อนและหลังการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS ดังแสดงในตารางที่ 3 ในประเด็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 3 at%) ในเนื้อฟิล์ม ภายหลังการอบอ่อนที่อุณหภูมิสูงถึง 900°C ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ที่ไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบออกไซด์ชนิดใดเลย เพราะถึงแม้ก่อนการเคลือบฟิล์มผู้วิจัยสามารถสร้างความดันพื้น (base pressure) โดยลดความดันภายในห้องเคลือบจนมีค่าต่ำมากเท่ากับ 5.0×10^{-5} mbar แต่ก็ยังอาจมีออกซิเจนหลงเหลือหรือคงค้างอยู่ภายใต้ห้องเคลือบซึ่งทำให้ฟิล์มที่เคลือบได้ก่อนนำไปอบอ่อน ยังมีปริมาณออกซิเจนคงเหลือในชั้นฟิล์มประมาณ 18.27 at% และเมื่อนำฟิล์มที่เคลือบได้ไปอบอ่อน ความร้อนที่อุณหภูมิสูงของกระบวนการอบอ่อนก็อาจทำให้ออกซิเจนในบรรยายกาศแพร่เข้าสู่ภายในของชั้นฟิล์ม ซึ่งสามารถตรวจพบปริมาณออกซิเจนในชั้นฟิล์มหลังการอบอ่อนประมาณ 21.62 at% ซึ่งปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นนี้ก็อาจยังไม่มากพอที่จะฟอร์มตัวเป็นสารประกอบออกไซด์หรืออาจมีการฟอร์มตัวเป็นสารประกอบออกไซด์แล้ว แต่มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบสัมฐานจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยเทคนิค XRD และนอกจากนี้หากเบรียบนเทียนผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยนี้กับผลการวิจัยของ Khamseh และคณะ (2010) ซึ่งศึกษาสมบัติต้านทานการเกิดออกซิเดชันของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ โดยนำฟิล์มไปอบอ่อนในอากาศที่อุณหภูมิในช่วง $700 - 1,000^{\circ}\text{C}$ ซึ่ง Khamseh และคณะ พบร่วมกับฟิล์มที่ใช้ศึกษาสามารถต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 900°C และยังพบว่าฟิล์มที่ใช้ในการศึกษาจะเกิดออกซิเดชันหลังการอบอ่อนที่อุณหภูมิ $1,000^{\circ}\text{C}$ โดยพบเพื่อของทั้งสารประกอบออกไซด์ของโครเมียมและอะลูมิเนียมจากเทคนิค XRD นอกจากนี้ยังพบว่าฟิล์มที่เกิดออกซิเดชันหลังการอบอ่อนที่อุณหภูมิ $1,000^{\circ}\text{C}$ จะมีปริมาณออกซิเจนในชั้นฟิล์มเพิ่มสูงขึ้นถึง 64.1 at% [10] ซึ่งสัมพันธ์และสอดคล้องกับผลการศึกษาของผู้วิจัยในงานวิจัยนี้ ซึ่งพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มี่อนนำไปอบอ่อนที่อุณหภูมิ 900°C สามารถตรวจพบปริมาณออกซิเจนในชั้นฟิล์มได้เพียง 21.62 at% เท่านั้น (เพิ่มขึ้นจากฟิล์มที่เคลือบได้ก่อนการอบอ่อนประมาณ 3 at%) ดังนั้นผลจากเทคนิค EDS นี้ จึงเป็นการสนับสนุนและยืนยันว่าฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่เตรียมได้ในงานวิจัยนี้สามารถต้านทานการเกิดออกซิเดชันได้สูงถึง 900°C

รูปที่ 3 แสดงลักษณะพื้นผิวและโครงสร้างจุลภาคของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ จากราบพัฒนาโดยโครงสร้างจุลภาคของฟิล์มด้วยเทคนิค FE-SEM พบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอบอ่อน โดยฟิล์มที่เคลือบได้ก่อนการอบอ่อน (รูปที่ 3(a)) ผิวน้ำของฟิล์มนีลักษณะเรียบ โดยเกรนของฟิล์มนีลักษณะเล็กและอ่อนตัวส่วนมากทั่วพื้นผิวของฟิล์ม และเมื่อนำฟิล์มที่ได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิในช่วง $500 - 900^{\circ}\text{C}$ พบร่วมกับ



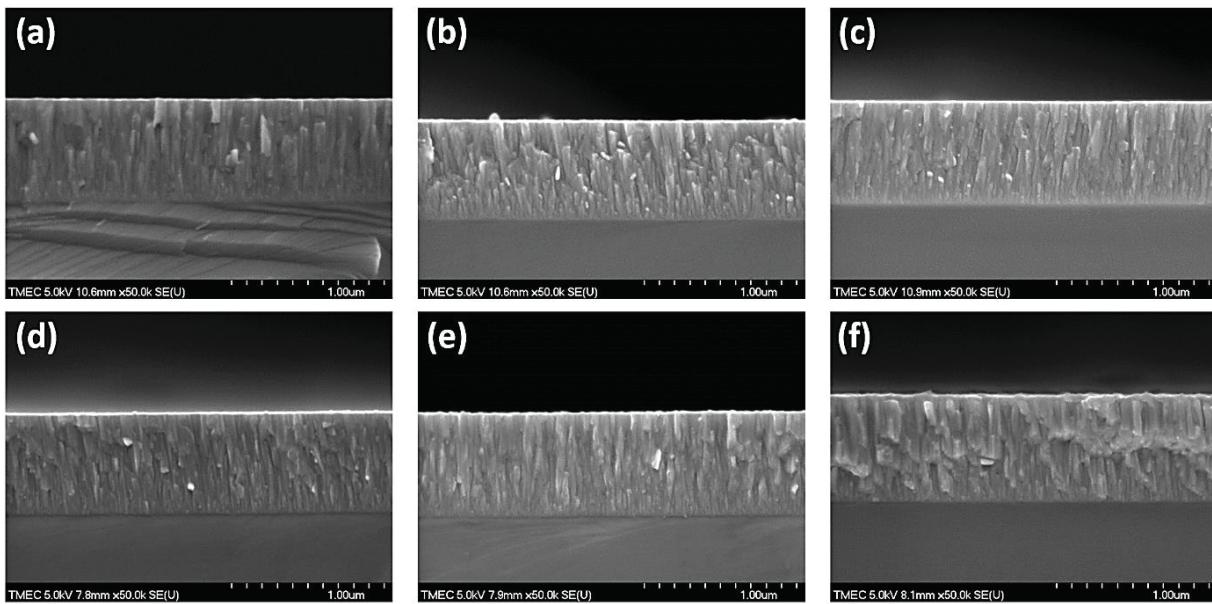
บนผิวน้ำของฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากจนแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยเกรนของฟิล์มยังคงมีลักษณะเล็กๆ ละเอียดกระจายตัวเหมือนเดิม ดังแสดงในรูปที่ 3(b) - รูปที่ 3(f)

รูปที่ 4 แสดงภาคตัดขวางของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่เคลือบได้ก่อนการอบอ่อน (รูปที่ 4(a)) และภาคตัดขวางของฟิล์มหลังการอบอ่อนที่อุณหภูมิต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาพพร้อมดับจุลภาคจากเทคนิค FE-SEM โดยพบว่า ฟิล์มที่เคลือบได้ก่อนการอบอ่อนมีลักษณะเป็นแท่งเรียงซิดติดกันหนาแน่นอย่างสม่ำเสมอโดยมีช่องว่าง (Void) ภายในเนื้อฟิล์มระหว่างเกรนเพียงเล็กน้อยซึ่งตรงกับ Zone 2 ตามแบบจำลองແฉบุโครงสร้างของธอร์ตัน (Thornton structure zone model) [11] และเมื่อนำฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่เคลือบได้ไปอบอ่อนในอากาศที่อุณหภูมิอบอ่อนในช่วง 500 - 900 °C (รูปที่ 4(b) - 4(f)) พบร่วมกับโครงสร้างของฟิล์มยังคงมีลักษณะเป็นแท่งเรียงซิดติดกันอย่างหนาแน่นสม่ำเสมอในลักษณะของโครงสร้างแบบคล้มnarf ตลอดทั้งภาคตัดขวางของฟิล์ม ซึ่งตรงกับ Zone 2 ตามแบบจำลองແฉบุโครงสร้างของธอร์ตัน [11] ผลจากการวิเคราะห์ฟิล์มจากเทคนิค FE-SEM ในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าความร้อนจากกระบวนการอบอ่อนที่อุณหภูมิในช่วง 500 - 900 °C ไม่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและภาคตัดขวางของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้หรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ฟิล์มบางที่เคลือบได้ในงานวิจัยนี้ทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 900 °C



ภาพที่ 3 ลักษณะพื้นผิวน้ำของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่อุณหภูมิอบอ่อนต่าง ๆ

(a) อุณหภูมิห้อง (b) 500 °C (c) 600 °C (d) 700 °C (e) 800 °C (f) 900 °C



ภาพที่ 4 ภาคตัดขวางของฟิล์มบางครอเมียมอะลูมิเนียมในไตรด์ที่อุณหภูมิอบอุ่นต่าง ๆ

(a) ອຸນທຸກມີຫ້ອງ (b) $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ (c) $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ (d) $700\text{ }^{\circ}\text{C}$ (e) $800\text{ }^{\circ}\text{C}$ (f) $900\text{ }^{\circ}\text{C}$

4. สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้สามารถเคลือบฟิล์มบางโคโรเมียมอะลูมิเนียมในไตรต์ (CrAlN) บนแผ่นซิลิคอนที่ใช้เป็นวัสดุรองรับด้วยเทคนิครีแอคตีฟเดซิอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริ่งจากเป้าสารเคลือบแบบอัลลอยได้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องให้ความร้อนหรือศักย์ไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นพิเศษแก้วัสดุรองรับ ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มบางซึ่งเคลือบได้ที่อุณหภูมิห้องมีโครงสร้างเป็นสารละลายของแข็งของ ($\text{Cr}_x\text{Al}_y\text{N}$) ที่ระนาบ (111), (200) และ (220) โดยฟิล์มที่ได้ก่อนและหลังการอบอ่อนมีโครงสร้างในระดับนาโนเมตรกล่าวคือขนาดผลึกเฉลี่ยทุกระนาบทองฟิล์มมีขนาดน้อยกว่า 25 nm โดยก่อนอบอ่อนฟิล์มมีขนาดผลึกเฉลี่ยเท่ากับ 15.7 nm และภายหลังการอบอ่อนขนาดผลึกเฉลี่ยของฟิล์มทุกระนาบมีค่าในช่วง 13.4 – 22.1 nm ส่วนค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มมีค่าในช่วง 4.055 - 4.139 Å ตามลำดับ ทั้งนี้ฟิล์มที่ได้มีรัตตุครามีเมียม อะลูมิเนียมและในโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยมีอักษรเจนเจือปนอยู่บางส่วน เมื่อนำฟิล์มที่ได้ไปอบอ่อนในอากาศเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิต่าง ๆ ในช่วง 500 - 900 °C พบว่าความเป็นผลึกของฟิล์มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่ใช้ในการอบอ่อน นอกจากนี้ผลจาก XRD ยังไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนของโคโรเมียมหรืออะลูมิเนียม รวมถึงไม่พบรูปแบบการเลี้ยวเบนของสารประกอบออกไซด์ทั้งโคโรเมียมและอะลูมิเนียมอีกด้วย ทั้งนี้นำฟิล์มที่เคลือบได้ไปอบอ่อนที่อุณหภูมิในช่วง 500 - 900 °C พบว่าความเป็นผลึกของฟิล์มมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอบอ่อน ส่วนผลการศึกษาโครงสร้างจุลภาค ลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิล์มทั้งหมดจากเทคนิค FE-SEM แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างจุลภาค ลักษณะพื้นผิวและภาคตัดขวางของฟิล์มที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิอบอ่อนโดยพบว่าลักษณะพื้นผิวของฟิล์มทั้งหมดมีลักษณะเป็นเกรนขนาดเล็กกระจายตัวสม่ำเสมอ ผลจากภาคตัดขวางแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของฟิล์มมีลักษณะเป็นแท่งเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นสม่ำเสมอซึ่งเป็นลักษณะของโครงสร้างแบบคลัมนานร์ สำหรับองค์ประกอบทางเคมีของฟิล์มพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ใช้อบอ่อนเล็กน้อยเท่านั้น โดยพบว่า ปริมาณโคโรเมียมอะลูมิเนียมและในโตรเจน มีค่าลดลงเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณออกซิเจนมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้



ยังพบว่าเมื่ออุณหภูมิอบอุ่นเพิ่มขึ้นสูงถึง 900°C ปริมาณออกซิเจนในฟิล์มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 3 at%) อีกทั้งยังไม่พบโครงสร้างผลึกหรือขั้นออกไซด์ใด ๆ ทั้งของโครงเมียมและอะลูминием ผลการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าการอบอุ่นฟิล์มบางโครงเมียมอะลูминиемในไตรด์ที่ได้ในงานวิจัยนี้ที่อุณหภูมิอบอุ่นต่าง ๆ ไม่มีผลต่อโครงสร้างและสัณฐานวิทยาของฟิล์มบางที่ได้ นอกจากนี้ที่สำคัญคือฟิล์มบางโครงเมียมอะลูминиемในไตรด์ที่เคลือบหรือเตรียมได้ในงานวิจัยนี้ซึ่งมีการเจืออะลูминиемเข้าไปในโครงสร้างของโครงเมียมในไตรด์สามารถต้านทานการเกิดออกซิเดชันเนื่องจากความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 900°C

5. เอกสารอ้างอิง

- [1] Shi, P.Z., Wang, J., Tian, C.X., Li, Z.G., Zhang, G.D., Fu, D.J., & Yang, B. (2013). Structure, mechanical and tribological properties of CrN thick coatings deposited by circular combined tubular arc ion plating. *Surface and Coatings Technology*, 288, S534-S537.
- [2] Wang, L., Zhang, S., Chen, Z., Li, J., & Li, M. (2012). Influence of deposition parameters on hard Cr-Al-N coatings deposited by multi-arc ion plating. *Applied Surface Science*, 258, 3629-3636.
- [3] Li, Z., Munroe, P., Jiang, Z.T., Zhao, X., Xu, J., Zhou, Z.F., Jiang, J.Q., Fang, F., & Xie, Z.H. (2012). Designing superhard, self-toughening CrAlN coatings through grain boundary engineering. *Acta Materialia*, 60, 5735-5744.
- [4] Chantharangsri, C., Denchitcharoen, S., Chaiyakun, S., & Limsuwan, P. (2012). Structure and surface morphology of Cr-Zr-N thin films deposited by reactive DC magnetron sputtering. *Procedia Engineering*, 32, 868-874.
- [5] Xingrun, R., Zhu, H., Meixia, L., Jiangao, Y., & Hao, C. (2018). Comparison of microstructure and tribological behaviors of CrAlN and CrN film deposited by DC magnetron sputtering. *Rare Metal Materials and Engineering*, 47(4), 1100-1106.
- [6] Khambun, A., Buranawong, A., & Witit-anun, N. (2017). Structural characterization of reactive DC magnetron co-sputtered nanocrystalline CrAlN thin film. *Key Engineering Materials*, 751, 1662-9795.
- [7] Alaksanasuwan, S., Buranawong, A., & Witit-anun, N. (2020). Effect of sputtering current on structure of TiCrN thin films prepared from mosaic target by reactive DC magnetron sputtering. *Applied Mechanics and Materials*, 901, 37-42.
- [8] Vyas, A., Zhou, Z. F., & Shen, Y. S. (2018). Effect of aluminum contents on sputter deposited CrAlN thin films. *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering*, 307, 012079. DOI:10.1088/1754-899/307/1/012079.
- [9] Holder, C. F., & Schaak, R. E. (2019). Tutorial on powder X-ray diffraction for characterizing nanoscale materials. *Acs Nano*, 13(7), 7359-7365. DOI: 10.1021/acsnano.9b05157.



- [10] Khamseh, S., Nose, M., Kawabata, T., Matsuda, K., & Ikeno, S. (2010). Oxidation resistance of CrAlN films with different microstructures prepared by pulsed DC balanced magnetron sputtering system. *Materials Transctions*, 51(2), 271-276.
- [11] Kusano, E. (2019). Structure-zone modeling of sputter-deposited thin films: a brief review. *Applied Science and Convergence Technology*, 28(6), 179-185.